

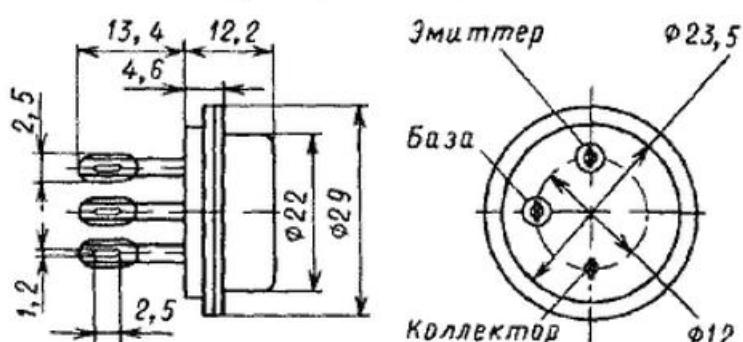
2T809A, KT809A

Транзисторы кремниевые меза-планарные *n-p-n* переключательные
низкочастотные мощные

Предназначены для работы в ключевых и импульсных схемах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 22 г, накидного фланца не более 10 г.

<http://lampilich.pared.ru/>



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при

$$I_K = 2 \text{ A}, I_B = 0.4 \text{ A}, I_C = 1.6 \text{ A}, V_{CE} = 0.22^* - 0.6^* = 1.5 \text{ V}$$

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k =$

$$= 2 \text{ A}, I_5 = 0.4 \text{ A}, \dots, I_{10} = 1.03^* - 1.3^* - 2.3 \text{ B}$$

Статический коэффициент передачи тока в схеме

общим эмиттером при $U_{\text{КЭ}} = 5$ В, $I_K = 2$ А.

при $T = 298$ К 15-100

при $T = 398$ К 15-130

при $T = 213$ К

ремя включения* при $I_K = 2 \text{ A}$, $I_B = 0,5 \text{ A}$,

"типовое значение

ремя спада* при $I_K = 2 \text{ A}$, $I_B = 0,5 \text{ A}$, $\tau_n =$

типовое значение

ремя рассасывания* при $I_K = 2 \text{ A}$, $I_B = 0,5 \text{ A}$,

типовое значение 16

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 3.3 \text{ МГц}$, $K_{\text{т}} = 5 \text{ В}^{-1}$, $\theta = 5^\circ$

$= 3,0 \text{ МГц}$, $U_{\text{КЭ}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{K}} = 0,5 \text{ А}$ не менее . . .

обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{K3} = 400$ В, $R_s = 10$ Ом на базу.

при $T = 298$ К и $T = 213$ К

ppm $T = 298$ K and $T = 213$ K 10 M

обратный ток эмиттера при $U_C = 4$ В не более

Емкость коллекторного перехода при $U_C = 5$ В $190 - 220 - 270 \text{ пФ}$